



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H558

对应国外型号
BC558

主要用途

开关、视频放大。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度..... -55~150

T_j ——结温..... 150

P_C ——集电极耗散功率.....500mW

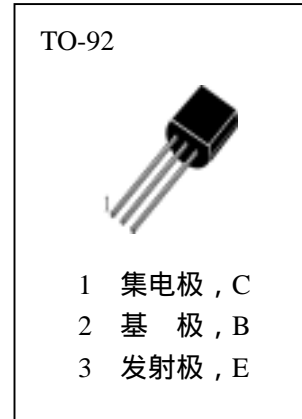
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....-30V

V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....-30V

V_{EBO} ——发射极—基极电压.....-5V

I_C ——集电极电流.....-100mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-30			V	$I_C=-100\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-30			V	$I_C=-10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-100\mu A, I_C=0$
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			-15	nA	$V_{CB}=-30V, I_E=0$
H_{FE}	直流电流增益	110		800		$V_{CE}=-5V, I_C=-2mA$
$V_{CE(sat1)}$	集电极—发射极饱和电压	-90		-300	mV	$I_C=-10mA, I_B=-0.5mA$
$V_{CE(sat2)}$		-250		-650	mV	$I_C=-100mA, I_B=-5mA$
$V_{BE(sat1)}$	基极—发射极饱和电压	-700			mV	$I_C=-10mA, I_B=-0.5mA$
$V_{BE(sat2)}$		-900			mV	$I_C=-100mA, I_B=-5mA$
$V_{BE(on1)}$	基极—发射极导通电压	-660		-750	mV	$V_{CE}=-5V, I_C=-2mA$
$V_{BE(on2)}$				-800	mV	$V_{CE}=-5V, I_C=-10mA$
f_T	特征频率		150		MHZ	$V_{CE}=-5V, I_C=-10mA, f=1MHz$
C_{ob}	输出电容			6	pF	$V_{CE}=-10V, I_C=0, f=1MHz$

分档及其标志

A	B	C
110—220	200—450	420—800